

ПРПГР3 Деев П.М. студ., МГУ, Москва	Исследование методом спектроскопии фотоотражения механических деформаций и плотности зарядовых состояний в слоях LT-GaAs/Si(100)
ПРПГР4 Душник А.И. студ., БГУИР, Минск	Определение площади фрактальной поверхности
ПРПГР5 Есин М.Ю. асп., ИФП СО РАН, Новосибирск	Упорядочение островков Ge на ступенчатой поверхности Si(100)
ПРПГР6 Зотов А.О. студ., МИЭТ, Москва	Электрическая проводимость гетероструктуры Cu/ZnO/Si
ПРПГР7 Козлова М.В. студ., СПбПУ, С.-Петербург	Влияние отжига в восстановительной атмосфере на структуру и свойства графена
ПРПГР8 Коляда Д.В. студ., СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург	Фотолюминесцентные свойства автоэпитаксиальных слоёв арсенида индия и влияние на них сульфидизации подложки
ПРПГР9 Комаров А.В. студ., МФТИ, Москва	Неупорядоченные плазмонные наноструктуры: изготовление, оптические и магнитооптические свойства
ПРПГР10 Лискин Д.А. асп., Нижегородский ГУ	Фотопроводимость плёнок $ZrO_2(Y)$ со встроенными наночастицами Au
ПРПГР11 Лубянский Я.В. инж.-исслед., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург	Исследование пленок нитрида алюминия, полученных методом реактивного ионно-плазменного распыления
ПРПГР12 Миронов С.А. асп., Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва	Формирование пленок Pt_3Si/Pt_2Si на подложках из поликристаллического Si при комнатной температуре
ПРПГР13 Митрофанов М.И. м.н.с., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург	Травление сфокусированным ионным пучком Ga подложек Si_3N_4/GaN для субмикронной селективной эпитаксии
ПРПГР14 Пилипенко Н.В. студ., СПбГУ, С.-Петербург	Уровни электронных состояний интерфейса кремния с нитридом алюминия, полученного реактивным магнетронным напылением
ПРПГР15 Прасолов Н. Д. асп., НИУ ИТМО, С.-Петербург	Моделирование методами молекулярной динамики процесса нанотрибологической модификации свойств поверхности кристаллических материалов зондом атомно-силового микроскопа

ПРПГР16 Родякина Е.Е. н.с., ИФП СО РАН, Новосибирск	Создание упорядоченных наноструктур с характерными размерами менее 100 нм методом электронно-лучевой литографии
ПРПГР17 Рыбин Н.Е. студ., Новосибирский ГУ	Распределение адатомов на экстраширокой террасе Si(111)-(1×1)
ПРПГР18 Спирина А.А. студ., Новосибирский ГТУ	Моделирование процессов отжига полупроводников $A^{III}B^V$ методом Монте-Карло
ПРПГР19 Стручков Н.С. студ., НИУ МИЭТ, Москва	Разработка и исследование методов локального восстановления тонких пленок оксида графена модулированным лазерным излучением
ПРПГР20 Уваров А.В. асп., Академический университет, С.-Петербург	Оптические свойства GaP, полученного методом плазмохимического атомно-слоевого осаждения

3. ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ, СВЕРХРЕШЕТКИ, КВАНТОВЫЕ ЯМЫ (ГСКЯ)

ГСКЯ1 Базалевский М.А. инж., ФИАН, Москва	Молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур GaAs/Ge/GaAs для нелинейно-оптических преобразователей
ГСКЯ2 Балахтарь Г.Р. студ., СПбПУ, С.-Петербург	Межподзонные примесные переходы в квантовой яме
ГСКЯ3 Белов П. А. асс., СПбГУ, С.-Петербург	Энергия связи экситонов в узких квантовых ямах
ГСКЯ4 Дашин С.А. студ., СПбГУ, С.-Петербург	Экситоны в низкодобротных микрорезонаторах с квантовыми ямами
ГСКЯ5 Дегтярев В.Е. асп., Нижегородский ГУ	Численный расчёт спин-орбитального взаимодействия Рашбы и Дрессельхауза в квантовых ямах на основе материалов $A^{III}B^V$
ГСКЯ6 Дубровский С.В. студ., СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург	Самосогласованное решение уравнений Шредингера и Пуассона для структур с ограниченными размерами численными методами в среде разработки LABVIEW
ГСКЯ7 Клековкин А.В. асп., ФИАН, Москва	Исследование перехода от не прямой к прямой запрещенной зоне в эпитаксиальных слоях $Ge_{1-x}Sn_x$
ГСКЯ8 Туктамышев А.Р. асп., ИФП СО РАН, Новосибирск	Получение и оптические свойства многослойных структур с квантовыми ямами Ge-Si-Sn